



压控晶体振荡器

Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)



表面贴装型VCXO KV5032D-C3系列

CMOS/ 3.3V/ 5.0×3.2mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 小型陶瓷封装类型
- 高可靠性的缝焊
- CMOS输出
- 电源电压 Vcc=3.3V
- 低抖动

■频率容差 (Overall)

容差 代号 × 10 ⁻⁶	工作温度范围 (°C)	备注
0 ±50	-10 ~ +70	标准规范
S ±30	-10 ~ +70	工作频率敬请咨询。
G ±50	-40 ~ +85	

■型号表示方法

KV5032D 24.5760 C 3 □ D 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②输出频率
- ③输出形式 (CMOS)
- ④电源电压 (3.3V)
- ⑤频率容差 (参见左表)
- ⑥对称/INH功能/ 控制输入电阻的组合
- ⑦个别规格 (产品目录以00标示)

包装方式 (载带包装 1000个/卷盘)

■规格

项 目	记 号	条 件	Min.	Max.	单 位	
输出频率范围*	f _o		1.5	30	MHz	
频率容差	f _{tol}	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、 电源电压变化、负载容量变化、长期变 化(1年@25°C)、包括振动和冲击	Temp.: -10 ~ +70°C / -40 ~ +85°C	-50	+50	× 10 ⁻⁶
			Temp.: -10 ~ +70°C	-30	+30	
绝对频率可变范围 (APR)	APR	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz	±100	—	× 10 ⁻⁶	
控制电压	V _c		0	+3.3	V	
储存温度范围	T _{stg}		-55	+125	°C	
工作温度范围	T _{use}	标准规范	-10	+70	°C	
		选项	-40	+85		
最大的额定电压	—	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz	-0.5	+7	V	
电源电压	V _{cc}		+2.97	+3.63	V	
电流消耗	I _{cc}	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz	—	15	mA	
禁用时电流	I _{dis}	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz	—	10	mA	
波形对称	SYM	@50% V _{cc}	45	55	%	
上升/下降时间 (10% V _{cc} ~ 90% V _{cc})	Tr/ Tf	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz	—	8	ns	
L电平输出电压	VoL		—	10% V _{cc}	V	
H电平输出电压	VoH		90% V _{cc}	—	V	
输出负载条件 (CMOS)	L _{CMOS}	CMOS Output	—	15	pF	
输入电压范围	V _{in}		0	+3.3	V	
L电平输入电压	ViL		—	30% V _{cc}	V	
H电平输入电压	ViH		70% V _{cc}	—	V	
控制输入电阻	—	控制输入电阻值代号⑥: D	100	—	k ohm	
		控制输入电阻值代号⑥: G	5	—	Mohm	
禁用时间	t _{dis}		—	100	ns	
启用时间	t _{ena}	1.5 ≤ f _o ≤ 30MHz	—	100	ns	
振荡启动时间	t _{str}	最小动作电压为0sec.	—	10	ms	

所有的电气特性是以最大负载时，并在工作温度范围内为条件。
 * 输出频率超出该范围的，敬请咨询。

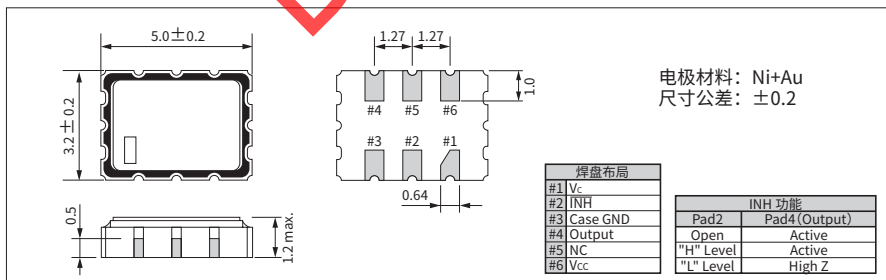


压控晶体振荡器



■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

